



**планар**

**КБТЭМ-ОМО**

## **Многоканальный лазерный генератор изображений ЭМ-5299Б**

Предназначен для прямой генерации изображений на полупроводниковых пластинах.

Позволяет :

- ♦ выполнять специализацию слоя межсоединений в производстве полузаказных СБИС;
- ♦ осуществлять последовательный перенос информации из САПР на пластины и изготавливать любые слои для заказных СБИС.

### **НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕНТРЫ СНГ**

Размер минимального элемента	800 нм
Адресная сетка	25 нм/50 нм
Неровность края:	
при дискретности адресации 25 нм	50 нм
при дискретности адресации 50 нм	100 нм
Погрешность совмещения слоев (2 $\sigma$ )	100 нм
Воспроизводимость размеров (3 $\sigma$ )	50 нм
Погрешность размеров	50 нм
Время экспонирования пластины диаметром 100 мм:	
при дискретности адресации 25 нм	40 мин
при дискретности адресации 50 нм	20 мин
Размеры области экспонирования	200×200 мм